

Röhrentype: Doppeldiode-Endpenthode  
Type de tube: double diode - penthode de sortie  
Type of tube: double diode - power pentode

Heizung indir., Gleich- oder Wechselstrom,  
 Serienspeisung  
 Chauffage indir., CC ou CA, alimentation Vf 55 V  
 en série If 0,100A  
 Heating indir., A.C. or D.C. series heater  
 supply

Kapazitäten  
 Capacités  
 Capacities

- a) Diodenteil Cd1k 1,8  $\mu$ F  
 Partie diodes Cd2k 2,0  $\mu$ F  
 Diode section Cd1d2 < 0,15  $\mu$ F
- b) Penthodenteil Cag1 < 1,2  $\mu$ F  
 Partie penthode  
 Pentode section
- c) Zwischen Dioden- und Penthodenteil  
 Entre les parties diodes et penthode  
 Between diode and pentode sections
- |       |                |            |                |
|-------|----------------|------------|----------------|
| Cd1g1 | < 0,1 $\mu$ F  | Cd2a       | < 0,02 $\mu$ F |
| Cd2g1 | < 0,05 $\mu$ F | C(d1+d2)g1 | < 0,2 $\mu$ F  |
| Cd1a  | < 0,06 $\mu$ F | C(d1+d2)a  | < 0,07 $\mu$ F |

Daten des Penthodenteiles zur Verwendung als einzelner  
 Endverstärker

Caracteristiques de la partie penthode, utilisation  
 comme amplificateur de sortie simple

Characteristics for use of the pentode section as single  
 tube power amplifier

Va	100	180	200 V
Vg2	100	180	200 V
Rk	140	140	200 $\Omega$
Vg1	-5,3	-10	-13 V
Ia	32,5	61	55 mA
Ig2	5,5	10	9,5 mA
S	7,5	9,0	8,0 mA/V
Ri	25000	22000	25000 $\Omega$
pg2g1	9,0	9,0	9,0
Ra	3000	3000	3500 $\Omega$
Wo	1,35	4,8	4,8 $\%$
dtot	10	10	10 $\%$
Vieff	3,8	6,2	6,2 V
Vieff (Wo=50 mW)	0,55	0,5	0,5 V

Grenzwerte für den Betrieb des Penthodenteiles

Limites fixées pour l'utilisation de la partie penthode  
 Limit ratings for operation of the pentode section

Va (Ia = 0)	max.	550 V
Va	max.	250 V
Wa	max.	11 W
Vg2 (Ig2 = 0)	max.	550 V
Vg2	max.	250 V

Wg2 (Vi = 0)	max.	1,9 W
Wg2 (Wo = max)	max.	3,5 W
Ik	max.	75 mA
Vg1 (Vg1 = +0,3 $\mu$ A)	max.	-1,3 V
Rglk	max.	1,0 M $\Omega$
Rfk	max.	20000 $\Omega$
Vfk	max.	150 V

Grenzwerte für den Betrieb des Diodenteiles  
 Limites fixées pour l'utilisation de la partie diode  
 Limit ratings for operation of the diode section

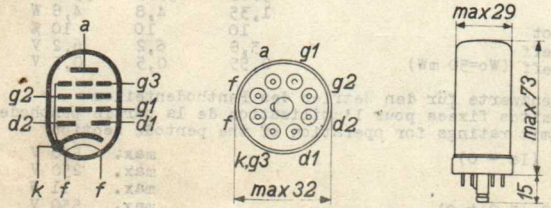
Vd1 <sup>1)</sup>	max.	200 V
Id1	max.	0,8 mA
Vd1 (Id1 = +0,3 $\mu$ A)	max.	-1,3 V
Vd2 <sup>1)</sup>	max.	200 V
Id2	max.	0,8 mA
Vd2 (Id2 = +0,3 $\mu$ A)	max.	-1,3 V

- 1) Scheitelwert; valeur de crête; peak value.
- d2 = ( Empfangsgerichterdiode  
 ) Diode détectrice  
 ( Detecting diode
  - ( Diode für A.L.R. und andere Zwecke  
 ) Diode pour le C.A.V. et d'autres utilisations  
 ( Diode for A.V.C. or other purposes

Wegen der Betriebsvorschriften, siehe auch EL 3. Mit Rücksicht auf Brumm soll keine höhere als eine 60-fache Verstärkung zwischen der Empfangsdiode und dem Gitter der Penthode angebracht werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Stift 8 an der geerdeten Seite liegt.

En ce qui concerne prescriptions d'utilisation, voir aussi le tube EL 3. Pour éviter le ronflement excessif on ne doit pas appliquer une plus forte amplification que 60 fois entre la diode détectrice et la grille de la penthode. Il est à remarquer que la broche 8 se trouve au côté mis à la terre.

As regards prescriptions for operation see also tube EL 3. In order to avoid excessive humming the gain between detecting diode and pentode grid should not be higher than 60. It should be taken into account that pin 8 lies on the earthed side



Abmessungen in mm. Dimensions en mm. Dimensions in mm.

